

**Kolloquium zur  
Halbleitertechnologie und Leistungselektronik**

Gemeinsames Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Messtechnik  
in Kombination mit der Veranstaltungsreihe „Leistungselektronik“  
(öffentliche Veranstaltungsreihe des Fraunhofer-Innovationsclusters  
Elektronik für nachhaltige Energienutzung)



**Veranstaltungen Wintersemester 2017/2018**

**Beginn der Veranstaltungen jeweils um 17:15 Uhr**  
**Ort: Hans-Georg-Waeber-Saal, Fraunhofer IISB, Schottkystraße 10, Erlangen**

---

Mo., 23.10.17 **Themenschwerpunkt Leistungselektronik:  
Packaging for Wide Band Gap**

---

Mo., 13.11.17 **Flip the Spin and Understand Recombination**  
Prof. Martin S. Brandt, *Walter-Schottky-Institut, TU München*

---

Mo., 20.11.17 **Themenschwerpunkt Leistungselektronik:  
Trends in Soft Magnetic Materials and Inductive Components  
Modelling for Power Electronic Systems**

---

Mo., 27.11.17 **Die Technologie des Vieldrahtsägens für den Photovoltaikmarkt:  
Ein- und Ausblicke**  
Dr. Oliver Anspach, *PV Crystalox Solar Silicon, Erfurt*

---

Mo., 04.12.17 **From Master of Advanced Optical Technologies to the most Advanced  
Optical Systems**  
Jan Lubkoll, *ASML Veldhoven/Niederlande*

---

Mo., 11.12.17 **4H-SiC Merged PiN Schottky Diodes for Wind Power Applications**  
Jonas Büttner, *Fraunhofer IISB, Erlangen*

---

Mo., 18.12.17 **Themenschwerpunkt Leistungselektronik**

---

**Kolloquium zur  
Halbleitertechnologie und Leistungselektronik**

Gemeinsames Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Messtechnik  
in Kombination mit der Veranstaltungsreihe „Leistungselektronik“  
(öffentliche Veranstaltungsreihe des Fraunhofer-Innovationsclusters  
Elektronik für nachhaltige Energienutzung)



**Veranstaltungen Wintersemester 2017/2018**

**Beginn der Veranstaltungen jeweils um 17:15 Uhr**

**Ort: Hans-Georg-Waeber-Saal, Fraunhofer IISB, Schottkystraße 10, Erlangen**

---

Mo., 08.01.18 **Lifetime Engineering in 4H-SiC by Technological Post-epi Processes**  
Jürgen Erlekampf, *Fraunhofer IISB, Erlangen*

---

Mo., 15.01.18 **Physikbasierte Kompaktmodellierung von SiC-MOSFETs**  
Matthäus Albrecht, *Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente, Universität  
Erlangen-Nürnberg*

---

Mo., 22.01.18 **Modellierung von ohmschen Kontakten auf p-SiC mit Hilfe einer  
Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>-Zwischenschicht**  
Matthias Kocher, *Fraunhofer IISB, Erlangen*

---

Mo., 29.01.18 **Themenschwerpunkt Leistungselektronik**

---

Mo., 05.02.18 **SiGeSn-basierte nanoelektronische Bauelementkonzepte  
und ihr Potential für die CMOS-Integration**  
Prof. Jörg Schulze, *Institut für Halbleitertechnik (IHT), Universität Stuttgart*

---